Люминесцентные свойства празеодима в некоторых фторидах

© А.С. Потапов, П.А. Родный, С.Б. Михрин, И.Р. Магунов*

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 195251 Санкт-Петербург, Россия * Физико-химический институт Национальной академии наук Украины,

65080 Одесса, Украина

E-mail: potapov@tuexph.stu.neva.ru

Работа является продолжением исследования каскадной эмиссии ионов Pr^{3+} в различных матрицах. В ней рассмотрены некоторые вопросы влияния окружения центров люминесценции на взаимное положение нижнего 5*d*-уровня и ${}^{1}S_{0}$, 4*f*-уровня иона Pr^{3+} , обнаружен эффект кластеризации PrF_{3} в BaF_{2} при высокой концентрации празеодима, показана перпективность использования магния в качестве зарядового компенсатора празеодима в $SrAlF_{5}$.

1. Введение

В последнее время уделяется большое внимание вопросам экологии и энергосберегающим технологиям: производится разработка новых экологически чистых материалов и новых технологий, позволяющих понизить энергопотребление бытовых приборов. В связи с этим возрос интерес к люминофорам, обладающим каскадной эмиссией фотонов (КЭФ). Такие люминофоры позволяют получить более одного (в идеальном случае — два) фотона в видимом диапазоне на каждый поглощенный квант вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) излучения. Во многих современных газоразрядных приборах (безртутных люминесцентных лампах, плазменных дисплейных панелях) ВУФ генерируется за счет разряда Ne-Xe плазмы. Максимум излучения этой плазмы наблюдается при 170 nm. Спектр возбуждения (поглощения) иона Pr³⁺ в ряде соединений имеет хорошее перекрытие со спектром излучения Ne-Xe плазмы [1], а система уровней Pr³⁺ удобна для получения КЭФ. В случае Pr³⁺ каскадная эмиссия представляет два последовательных излучательных перехода: ${}^{1}S_{0} \rightarrow {}^{1}I_{0}$ первая ступень и ${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}F_{J}$, ${}^{3}H_{J}$ — вторая ступень каскада. За последнее время обнаружено порядка двадцати люминофоров, обладающих каскадной эмиссией, например [2-4]. Для упрощения поиска новых люминофоров КЭФ была предложена система требований к матрице, гарантирующих наличие каскадной эмиссии [5]. Главным требованием к матрице для регистрации ¹S₀-люминесценции является слабое кристаллическое поле, обеспечивающее более высокое положение нижнего 5*d*-уровня по сравнению с ${}^{1}S_{0}$, 4*f*-уровнем празеодима. Для выполнения этого требования матрица должна обладать следующими свойствами: большой ионный радиус замещаемого катиона, большое расстояние Pr³⁺-анион, высокое координационное число для замещаемого катиона, низкая анизотропия излучающего центра, высокая электроотрицательность аниона, большой заряд и малый радиус катиона второй координационной сферы. Указанные правила не являются строгими. Например, радиус иона Ba^{2+} больше радиуса иона Sr^{2+} . Однако стронций оказывается более предпочтительным для замещения празеодимом, чем барий. Это связано

с тем, что ионный радиус стронция ближе к ионному радиусу Pr^{3+} . Вторая ступень КЭФ наблюдается, если выполнены дополнительные условия: низкая энергия фононов в матрице по сравнению с расстоянием между 4f-уровнями празеодима и относительно невысокая концентрация активатора.

В настоящей работе на примерах $BaF_2:Pr$ и $SrAlF_5:Pr$ рассмотрено влияние различных факторов на эффективность КЭФ.

2. Условия проведения эксперимента

Кристаллы BaF₂: Pr выращены в Государственном оптическом институте им. С.И. Вавилова методом Стокбаргера. Были изучены монокристаллы чистого фторида бария и фторида бария, активированного 0.3 и 3% празеодима.

Образцы SrAlF₅: Рг были получены твердофазным синтезом в Физико-химическом институте НАН Украины путем прокаливания тщательно приготовленных смесей фторидов стронция и алюминия. Полученные поликристаллические образцы подвергались рентгено-структурному анализу. В дальнейших измерениях использовались однофазные образцы.

Для измерения спектров люминесценции использовалась установка с непрерывным рентгеновским возбуждением (U = 40 kV, I = 14 mA) [6]. Кривые кинетики люминесценции были получены на установке с импульсным рентгеновским возбуждением (длительность импульса $\tau \approx 1 \text{ ns}, U = 30 \text{ kV}$) [7].

3. Экспериментальные результаты

На рис. 1 представлены спектры люминесценции фторида бария: чистого кристалла (кривая 1), кристалла, активированного 0.3% празеодима (кривая 2), и кристалла, активированного 3% празеодима (кривая 3). Во всех спектрах присутствует широкая полоса с максимумом около 300 nm. Кроме того, в спектре люминесценции $BaF_2:Pr(0.3\%)$ наблюдается интенсивная линия с максимумом при 480 nm, а в спектре люминесценции $BaF_2:Pr(3\%)$ присутствует интенсивная линия с максимумом при 392 nm. Кинетика люминесценции образца $BaF_2:Pr(3\%)$ во временном окне 800 ns приведена на рис. 2. В кинетике люминесценции можно выделить два компонента: быстрый с постоянной спада 39 ns и медленный с постоянной спада 690 ns.

На рис. 3 представлены спектры люминесценции образцов SrAlF₅: Pr(0.5%) при использовании различных зарядовых компенсаторов: магния (рис. 3 *a*) и натрия (рис. 3, *b*). Видно, что линия излучения, связанная с переходом ${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}H_{4}$, остается интенсивной в обоих случаях, в то время как эффективность первой ступени каскада оказывается существенно выше в случае использования магния в качестве зарядового компенсатора.

4. Анализ полученных данных

Широкая полоса с максимумом около 300 nm во всех трех спектрах люминесценции фторида бария (рис. 1) связана с собственной экситонной люминесценцией. По-



Рис. 1. Спектр люминесценции фторида бария: I — чистого, $2 - BaF_2: Pr(0.3\%), 3 - BaF_2: Pr(3\%).$



Рис. 2. Кинетика люминесценции $BaF_2: Pr(3\%)$.



Рис. 3. Спектр люминесценции образца SrAlF₅: Pr(0.5%): a - c зарядовым компенсатором Mg^{2+} , b - c зарядовым компенсатором Na^+ .

стоянная спада этой люминесценции составляет 680 ns (медленная компонента рис. 2), что хорошо согласуется с полученными ранее данными [8].

Оценка взаимного положения нижнего 5*d*-уровня и ${}^{1}S_{0}$, 4*f*-уровня иона \Pr^{3+} во фториде бария показала, что в этом материале происходит перекрытие ${}^{1}S_{0}$ -уровня и 5*d*-подзоны. Таким образом, во фториде бария, активированным празеодимом, ${}^{1}S_{0}$ -люминесценция должна быть потушена. Это подтверждается видом спектра люминесценции BaF₂: Pr(0.3%) (кривая 2 на рис. 1). Аналогичная кривая была получена ранее [9]. Для объяснения наличия в спектре BaF₂: Pr(3%) линии, связанной с ${}^{1}S_{0} \rightarrow {}^{1}I_{0}$ -переходами (кривая 2 на рис. 1), заметим, что свечение празеодима в этом материале сходно с таковым в чистом PrF₃ [10].

Во фториде бария празеодим, замещающий барий, оказывается окруженным восемью ионами фтора. При столь низком координационном числе для празеодима КЭФ не наблюдается [5]. Для регистрации КЭФ во фторидах необходимо, чтобы координационное число для празеодима было не меньше 9. Вхождение трехвалентного празеодима на место двухвалентного бария приводит

к необходимости зарядовой компенсации. Подобным зарядовым компенсатором может выступать межузельный фтор. Во фториде празеодима катион окружен девятью анионами. На основании схожести спектров люминесценции $BaF_2: Pr(3\%)$ и PrF_3 полагаем, что во фториде бария при высокой концентрации празеодима происходит локальная перестройка решетки с образованием кластеров PrF₃. Образование подобных кластеров в системах $Me_{1-x}Ln_xF_{2+x}$ (Me — Ca, Sr, Ba; Ln — лантаноид) подробно разобрано в [11]. Указанное предположение позволяет объяснить отсутствие в $BaF_2: Pr(3\%)^{-3}P_0$ люминесценции: в PrF₃ она потушена за счет эффекта кросс-релаксации. Наличие быстрого компонента с $\tau = 39$ ns в кинетике люминесценции BaF₂: Pr(3%) можно объяснить частичным подмешиванием 5*d*-состояний к ${}^{1}S_{0}$ -состоянию иона Pr^{3+} [12].

Ширина линий в спектрах люминесценции SrAlF₅: Pr оказыается большей, чем в других материалах, активированных празеодимом, что связано с наличием в этом материале четырех неэквивалентных положений для празеодима, замещающего стронций [13]. Кроме того, наблюдается уширение линии люминесценции в спектре SrAlF₅: Pr,Na (puc. 3, b) по сравнению со спектром SrAlF₅: Pr,Mg (puc. 3, a), а также падение интенсивности ¹S₀-люминесценции в образце, содержащем натриевый компенсатор. Это указывает на сильное влияние зарядового компенсатора на вид спектра люминесценции. Полагаем, что в случае использования магния имеет место локальная компенсация заряда. Ион Na⁺, обладающий большим ионным радиусом (1.30 Å), замещает стронций (1.46 Å), в то время как ион Mg^{2+} с ионным радиусом 0.86 Å замещает алюминий (0.67 Å). В кристаллической решетке SrAlF₅ расстояние Sr-Al меньше, чем расстояние Sr-Sr. Таким образом, компенсация заряда происходит на меньшем расстоянии при использовании магния. Локальная компенсация заряда приводит к меньшему искажению люминесцирующего центра и как следствие к лучшим условиям для ¹S₀-люминесценции. При использовании натрия зарядовая компенсация выполняется на большом расстоянии, что приводит к высокой анизотропии центра люминесценции. Следствием этого является низкая интенсивность первой ступени каскада в случае SrAlF₅: Pr, Na. Дипольный момент системы компенсатор-излучающий центр в случае использования магния оказывается меньше, чем при использовании натрия, что может приводить к большему уширению линий в случае SrAlF₅: Pr,Na.

5. Заключение

В большинстве люминофоров КЭФ расстояние между нижним уровнем 5*d*-конфигурации и ${}^{1}S_{0}$, 4*f*-уровнем оказывается очень маленьким (0.1–0.2 eV). Из-за этого малейшее изменение в окружении центра люминесценции сказывается на эффективности первой ступени каскада (переходе ${}^{1}S_{0} \rightarrow {}^{1}I_{0}$).

Список литературы

- [1] I. de Boer. Stratech Report IRI-ISO-990035. Delft. (1999). 74 p.
- [2] E. Van der Kolk, P. Dorenbos, C.W.E. van Eijk, A.P. Vink, C. Fouassier, F. Cuillen. J. Lumin. 97, 212 (2002).
- [3] П.А. Родный, А.Н. Мишин, А.С. Потапов. Оптика и спектроскопия 93, 5, 775 (2002).
- [4] P.A. Rodnyi, S.B. Mikhrin, P. Dorenbos, E. var der Kolk, C.W.E. van Eijk, A.P. Vink, A.G. Avanesov. Optics Commun. 204, 237 (2002).
- [5] П.А. Родный. Оптика и спектроскопия 89, 4, 609 (2000).
- [6] A.S. Potapov, P.A. Rodnyi, S.B. Mikhrin. Radation Measurements 38, 839 (2004).
- [7] П.А. Родный, С.Б. Михрин, А.Н. Мишин. Письма в ЖТФ 26, 15, 72 (2000).
- [8] П.А. Родный, А.Н. Мишин, А.С. Потапов. Научно-технические ведомости СПбГТУ 4, 95 (2001).
- [9] W. Drozdowski, A.J. Wojtowicz. J. Alloys and Compounds 300–301, 261 (2000).
- [10] S. Kuck, I. Sokolska. Appl. Phys. A 77, 469 (2003).
- [11] B.P. Sobolev, A.M. Golubev, P. Herrero. Crystallography Rep. 48, *I*, 141 (2003).
- [12] S. Huang, X.-J. Wang, R.S. Meltzer, W.M. Yen. J. Lumin. 94–95, 119 (2001).
- [13] F. Kubel. Z. Anorg. Allg. Chem. 624, 1481 (1998).